ハイパスフィルタ · 85–2000 MHz

阻止域減衰量 · ≥40 dB (DC–50 MHz). 筐体寸法 (10 ± 0.2) × (7.5 ± 0.2) × (4 ± 0.3) mm.

RF 特性

項目	値
通過帯域	85–2000 MHz
通過帯域内挿入損失 [1]	≤2 dB
阻止域減衰量 [2]	≥40 dB
VSWR [1]	≤1.8:1

[1] 85–2000 MHz
[2] DC–50 MHz

設計定格 設計値

項目	値
許容電力	1 W
動作温度	−40...+70 °C
保存温度	−55...+85 °C

代表実測応答

周波数 (MHz)	S11 VSWR	S22 VSWR	S12 損失（dB）	S12 抑圧（dB）	S12 遅延（ns）
1	213.8	99.2	-67.46	-67.46	5.31
15	362.75	343.19	-47.83	-47.83	-
29	101.9	105.39	-56.17	-56.17	-15.49
44	28.29	27.7	-49.97	-49.97	-25.42
58	7.22	6.63	-25.57	-25.57	-3
72	1.35	1.27	-3	-3	22.66
86	1.16	1.07	-1.44	-1.44	9.97
101	1.24	1.25	-0.96	-0.96	5.68
115	1.24	1.28	-0.74	-0.74	3.93
129	1.21	1.26	-0.6	-0.6	2.98
143	1.18	1.23	-0.52	-0.52	2.38
157	1.15	1.2	-0.44	-0.44	1.91
172	1.13	1.17	-0.39	-0.39	1.62

代表実測応答

周波数 (MHz)	S11 VSWR	S22 VSWR	S12 損失（dB）	S12 抑圧（dB）	S12 遅延（ns）
186	1.11	1.15	-0.35	-0.35	1.39
200	1.09	1.13	-0.31	-0.31	1.22

機械仕様

項目	値
実装方式	表面実装
品質グレード	産業用
筐体寸法	(10 ±0.2) × (7.5 ±0.2) × (4 ±0.3) mm
パッケージRF端子の内縁間隔	8.8 mm
基板RFランドの内縁間隔	8.6 mm
対向するクリアランスの内縁間隔	7.2 mm
短辺方向のクリアランス開口幅	2.6 mm
パッケージRF端子幅	1.0 mm
基板RFランドの短辺方向幅	1.2 mm
パッケージRF端子の切り欠き径	Ø0.6 mm

実装とプリント基板レイアウト

底面視では、入出力を入れ替えられる2つのRF端子が対向する短辺の中央にあります。底面の斜線部はGNDです。基板中央寄りの各RFランドに50 Ω給電線を配線し、グラウンド銅箔との間隔を確保してください。フットプリントの周囲と下にグラウンドビアを設けてください。 推奨基板レイアウトには、誘電体厚0.254 mmのRO4350Bを使用します。 独立したキャビティへの実装を推奨します。十分な接地を確保するため、可能な限りパッケージの側面、上面および底面をアセンブリの金属筐体に密着させてください。接地が不十分だと阻止域の抑圧が低下します。220 °Cでのリフローはんだ付けに対応します。清掃時はフィルタを洗浄液に浸さず、表面のみを清掃してください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。